

a 2011 0026

Invenția se referă la procedee de obținere a materialelor semiconductoare și poate fi utilizată în tehnologia semiconductoare.

Procedeul de lichidare a deformației monocristalelor de ZnSe în procesul de răcire după creștere, crescute din fază gazoasă, pe fundul plat de grosime arbitrară al camerei de creștere închise, constă în utilizarea temperaturii de creștere aflate în diapazonul 900...1100°C, a gradientului de temperatură în regiunea de cristalizare 0...5°C/cm, a vitezei de încălzire a germenului de cristalizare și de răcire a cristalului crescut 20...60°C/oră cu utilizarea unui profil special de temperatură al cuptorului, necesar pentru lichidarea efectului de alipire a cristalelor de pereții fiolei.

Revendicări: 1

Figuri: 3